

**典型应用:**

- 输入信号整形
- 总线驱动

**主要指标:**

- 输入输出电平0V/5V
- 静态电流小于1 $\mu$ A
- 开关时间（典型） $t_{pd}$ =6ns
- 最高输入频率40MHz
- 芯片封装：3 $\times$ 3 $\times$ 0.75mm

**产品简介:**

八线缓冲驱动器芯片，采用 CMOS 工艺，逻辑功能与 54/74HCT244 一致，该芯片内含八个具有三态输出的缓冲器，两个输出允许控制（ENA\_N、ENB\_N），分别控制四个缓冲器。所有输入和输出均有内部保护线路，以减小由于静电感应而损坏器件的可能性，具有高抗噪声度和驱动负载的能力。没有信号输入时，使能端 ENA\_N、ENB\_N 默认为高电平，输入端 A<1:8>，默认为低电平。

**电参数**

序号	参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位	说明
1	静态电流	$I_{dd}$	-	-	1	$\mu$ A	-
2	驱动电流	$I_o$	-	3	-	mA	与负载有关
3	输入电流	$I_{in}$	-	-	1	$\mu$ A	
4	输出高电平电压	$V_{oh}$	-	5	-	V	
5	输出低电平电压	$V_{ol}$	-	0	-	V	
6	开关时间	$t_{pd}$	-	6	-	ns	F=40MHz,输入电平的 50%到输出电平的 50%
7	上升、下降时间	$t_{td}$	-	6	-	ns	F=40MHz,输出电平的 10%到输出电平的 90%

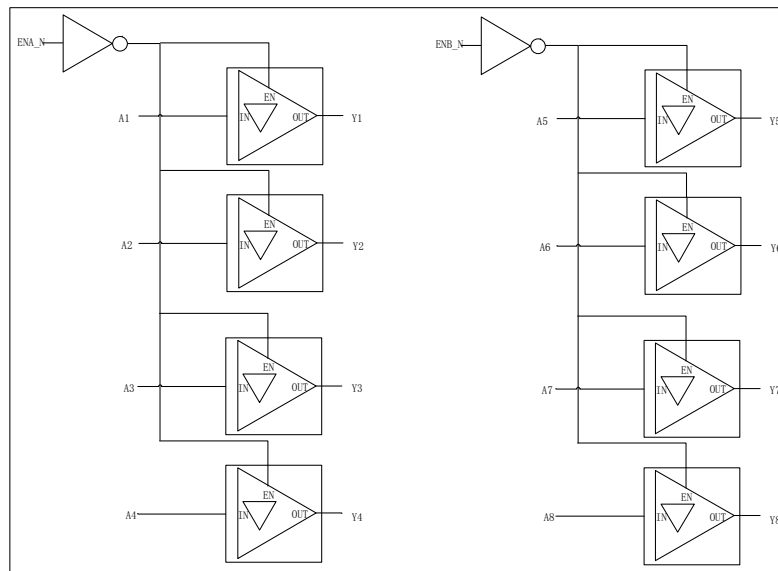
## 极限条件

项 目	符号	数 值		单位
		最小	最大	
电源电压	$V_{DD}$	-0.5	6	V
输入电压	$V_{in}$	-0.5	$V_{DD}+0.5$	V
驱动电流	$I_o$	-	10	mA
储存温度	$T_s$	-65	+150	°C

## 推荐工作条件

项目	符号	规范值		单位
		最小	最大	
电源电压	$V_{DD}$	4.5	5.5	V
输入高电平电压	$V_{ih}$	3	-	V
输入低电平电压	$V_{il}$	0	1	V
工作温度	$T_A$	-55	+125	°C

## 原理图



## 真值表

输入		输出
ENA_N	AN	YN
L	L	L
L	H	H
H	×	Z

输入		输出
ENB_N	AM	YM
L	L	L
L	H	H
H	×	Z

注：H 表示高电平，L 表示低电平，X 为任意态,Z 为高阻态, N=1,2,3,4,M=5,6,7,8 没有信号输入时，使能端 ENA\_N、ENB\_N 默认为高电平，输入端 AN、AM,默认为低电平。